

# Mario Bareiß

Landshuter Allee 85, 80637 München  
Telefon: +49 (0)89 41857126, Mobile: +49 (0)151 56692372  
E-Mail: mario\_bareiss@web.de

## Angaben zur Person

Staatsangehörigkeit Deutsch  
Geburtsort Hagen, Deutschland  
Geburtsdatum 15.07.1983



## Akademische Laufbahn

Seit Nov 2009 Technische Universität München

### Promotion in der Physik

Thema: „Nanoimprint and Nanotransfer for electronic devices“

Okt 2003 – Nov 2009 Technische Universität München

### Diplom in der Physik

Voraussichtlich mit sehr gutem Erfolg und Auszeichnung bestanden

Nov 2008 – Nov 2009 Diplomarbeit: „InAs(Sb)-Quantenpunkte auf InP-Substrat  
für eine Einzelphotonenquelle bei 1,55  $\mu\text{m}$ “

Okt 2003– Nov 2008 Studium mit Schwerpunkte in: Halbleiterphysik, Optoelektronik, Plasmaphysik,  
Grenzflächenphysik und Erneuerbare Energien

Sept 2006 – Juli 2007 Universidad Complutense de Madrid

Schwerpunkte in Elektronik und Halbleitertechnologie

Juli 1994 – Juni 2003 Michelberg Gymnasium Geislingen/Steige

Allgemeine Hochschulreife

## Univ. Nebentätigkeiten

Sept 2005 – Juni 2009 Nebentätigkeit als Tutor an der Technischen Universität München (TUM)

Betreuung des physikalischen Praktikums für Physik- und Ingenieurstudenten

Mai 2008 – Juli 2008 Studentische Hilfskraft an einem Elektrotechniklehrstuhl der TUM

Photolumineszenzspektroskopie bei tiefen Temperaturen (4 Kelvin)

März 2007 – Juni 2007 Laborant an der Universidad Complutense de Madrid (Spanien)

Messung des Seebeck Effekts in Peltierelementen (PE), Bau einer PE-LED

## Publikationen

In einer Fachzeitschrift  
eingereicht:

R. Enzmann, M. Bareiß, D. Baierl, G. Böhm, R. Meyer, J. Finley and M.-C. Amann

*Design and realization of low density InAs quantum dots on AlGaInAs lattice matched to InP(001)*

Journal of Applied Physics (2009)

Auf internationalen  
Konferenzen vorgestellt:

M. Bareiß, R. Enzmann, D. Baierl, G. Böhm, R. Meyer, J. Finley and M.-C. Amann

*Antimon assisted growth of InAs Quantum Dots*

Deutscher MBE Workshop 2009, Bochum, Germany (2009)

R. Enzmann, C. Jendrysik, M. Bareiß, G. Grasse, G. Böhm, R. Meyer, J. Finley and M.-C. Amann

*Concept of a single photon source based on InP for emission at 1.55  $\mu\text{m}$*

International Conference on Nanomaterials and Nanosystems (NanoMats2009), Istanbul, Turkey (2009)

R. Enzmann, M. Bareiß, M. Kraus, G. Böhm, R. Meyer, J. Finley and M.-C. Amann

*Growth of low-density quantum dots emitting at telecommunication wavelengths*

Semiconductor Integrated Optoelectronics Conference (SIOE), Cardiff, UK (2009)

M. Bareiß, R. Enzmann, M. Kraus, G. Böhm, R. Meyer, J. Finley and M.-C. Amann

*InAs Quantum Dots emitting at 1.55  $\mu\text{m}$  grown on InP substrate using MBE*

DPG Fruehjahrstagung, Dresden, Germany (2009)

R. Enzmann, M. Kraus, M. Bareiß, C. Seidel, D. Baierl, G. Böhm, R. Meyer, J. Finley and M.-C. Amann

*InAs Quantum Dots on AlGaInAs emitting in the optical C-Band at 1.55  $\mu\text{m}$*

21th International Conference on Indium Phosphide and Related Materials, Newport Beach, CA, USA (2009)

München, 11. Dezember 2009

M. Bareiß